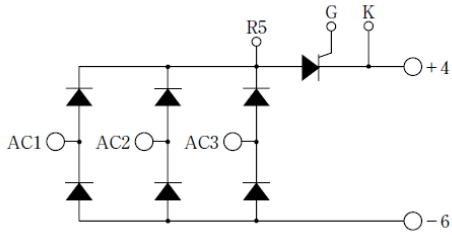


# THYRISTOR

## 100A Avg 1600 Volts

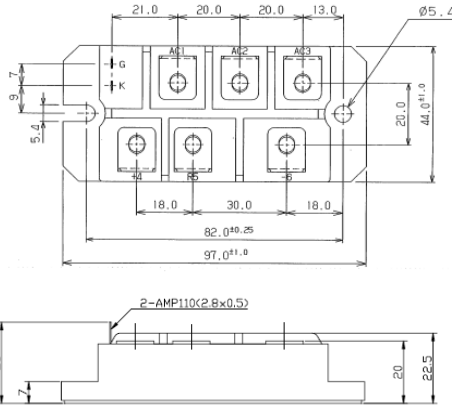
PGH100N16

### ■回路図 CIRCUIT



### ■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



### 総合定格・特性 Part of Diode Bridge & Thyristor

#### ■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit	
平均出力電流 Average Rectified Output Current	I <sub>o</sub> (AV)	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified	T <sub>C</sub> =121°C (電圧印加なし) Non-Biased for Thyristor	100	A
			T <sub>C</sub> = 96°C (電圧印加あり) Biased for Thyristor	100	
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>	125~150°Cは封入材部にて順阻止電圧を 印加しない事 T <sub>j</sub> >125°C, Can not be Biased for Thyristor	-40 ~ +150	°C	
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>		-40 ~ +125	°C	
絶縁耐圧 Isolation Voltage	Viso	端子-ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V	
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	サマルコパウト <sup>®</sup> 塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal		M5	2.4 ~ 2.8	
	ゲート端子部 Gate Terminal		-	-	

#### ■熱特性 Thermal Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(c-f)</sub>	ケース-フィン間(トータル)、サマルコパウト <sup>®</sup> 塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	°C/W

### ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 dies)

#### ■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RSM</sub>	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦半波, 1サージ, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1200	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2~10ms	7200	A <sup>2</sup> s
許容周波数 Allowable Operating Frequency	f		400	Hz

\*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 dies)

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I <sub>RM</sub>	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>RM</sub> = V <sub>RRM</sub>	7	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V <sub>FM</sub>	T <sub>j</sub> = 25°C, I <sub>FM</sub> = 100A	1.20	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部-ケース間(トータル) Junction to Case, Total	0.08	°CW

\*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor (1die)

■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off State Voltage	*2 V <sub>DRM</sub>	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non-Repetitive Peak Off State Voltage	*2 V <sub>DSM</sub>	1700	V

\*2 : 逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I <sub>TSM</sub>	50Hz 正弦半波, 1サージ, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	2000	A
電流二乗時間積 I Squared t	I <sup>2</sup> t	2~10ms	20000	A <sup>2</sup> s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub> , I <sub>TM</sub> = 2 · I <sub>O</sub> , T <sub>j</sub> = 125°C I <sub>G</sub> = 200mA, di <sub>G</sub> /dt = 0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P <sub>GM</sub>		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P <sub>G(AV)</sub>		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I <sub>GM</sub>		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V <sub>GM</sub>		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V <sub>RCM</sub>		5	V

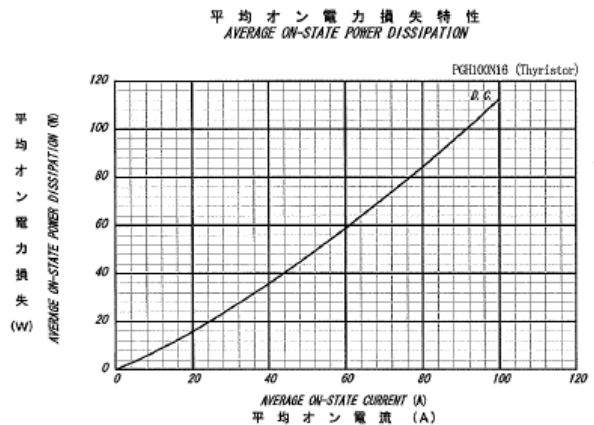
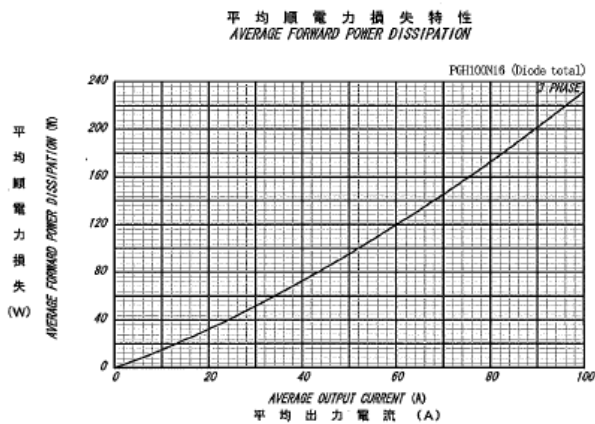
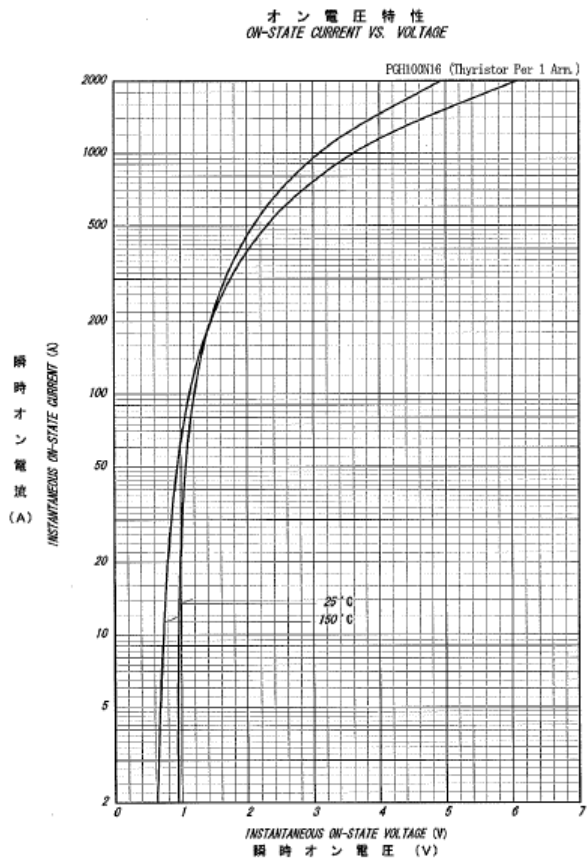
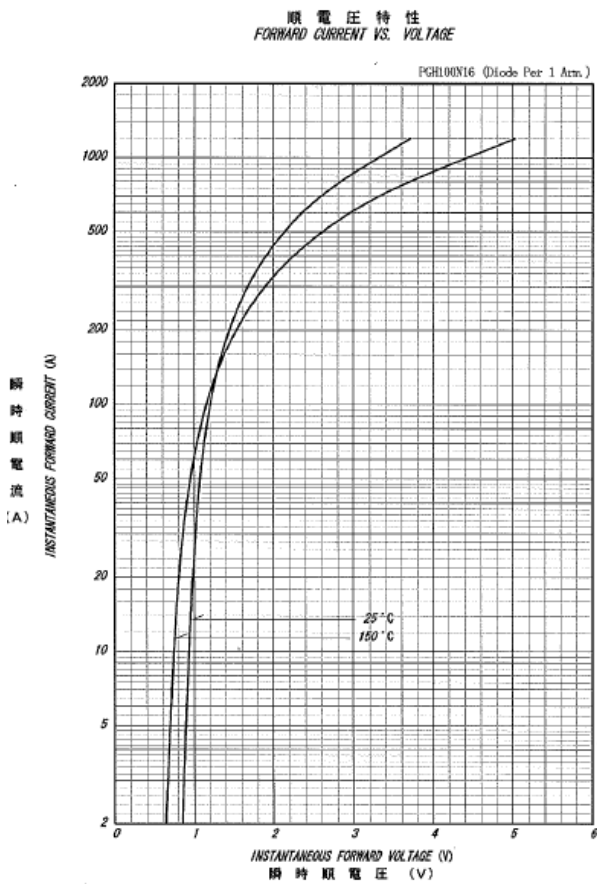
■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off State Current	I <sub>DM</sub>	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>DM</sub> = V <sub>DRM</sub>			20	mA
ピークオン電圧 Peak Off State Voltage	V <sub>TM</sub>	T <sub>j</sub> = 25°C, I <sub>TM</sub> = 100A			1.20	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> = 6 V, I <sub>T</sub> = 1A	T <sub>j</sub> = -40°C		200	mA
			T <sub>j</sub> = 25°C		100	
			T <sub>j</sub> = 125°C		50	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V <sub>GT</sub>	V <sub>D</sub> = 6 V, I <sub>T</sub> = 1A	T <sub>j</sub> = -40°C		4.0	V
			T <sub>j</sub> = 25°C		2.5	
			T <sub>j</sub> = 125°C		2.0	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V <sub>GD</sub>	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub>	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T <sub>j</sub> = 125°C, V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub>	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t <sub>q</sub>	T <sub>j</sub> = 125°C, I <sub>TM</sub> = I <sub>O</sub> , V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub> dv/dt = 20V/μs, V <sub>R</sub> = 100V, - di/dt = 20A/μs		150		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t <sub>gt</sub>	T <sub>j</sub> = 25°C, V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub> , I <sub>T</sub> = 3 · I <sub>O</sub> I <sub>G</sub> = 200mA, di <sub>G</sub> /dt = 0.2A/μs		6		μs

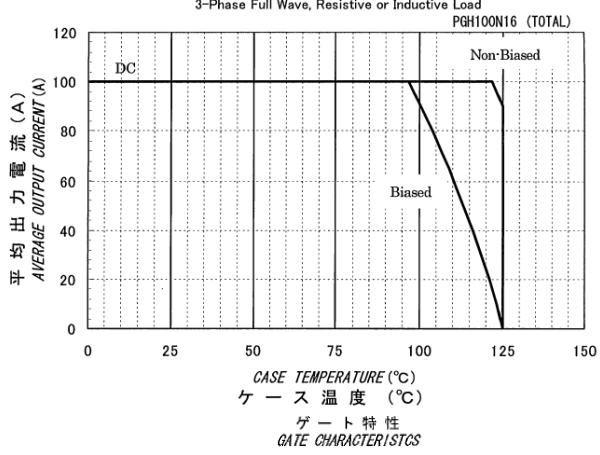
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
遅れ時間 Delay Time	$t_d$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $V_D=2/3 V_{\text{DRM}}$ , $I_T=3 \cdot I_O$ $I_G=200\text{mA}$ , $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		2		$\mu\text{s}$
立ち上がり時間 Rise Time	$t_r$			4		$\mu\text{s}$
ラッチング電流 Latching Current	$I_L$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100		mA
保持電流 Holding Current	$I_H$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		80		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{\text{th(j-c)}}$	接合部-ケース間 Junction to Case			0.25	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

■質量 Approximate Weight  
—— 約 225 g

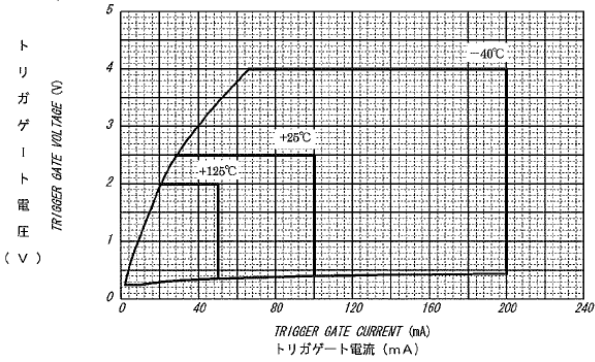
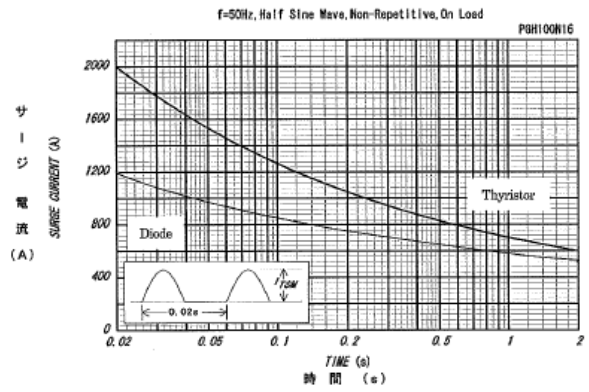
■定格・特性曲線



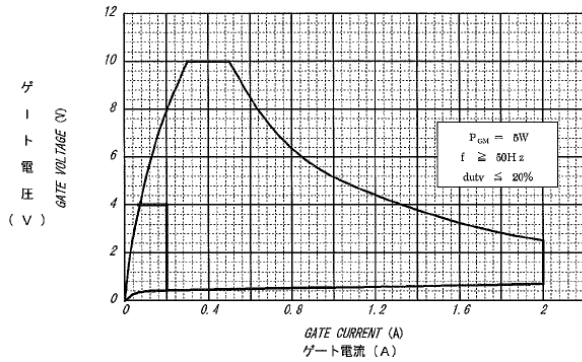
平均出力電流 - ケース温度定格  
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージ電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS



ゲート定格  
GATE RATINGS



過渡熱抵抗特性  
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE  
Junction to Case

